



Set XF1



- 内容:**
- H-Fieldプローブ XF-R 400-1
 - H-Fieldプローブ XF-R 3-1
 - H-Fieldプローブ XF-B 3-1
 - H-Fieldプローブ XF-U 2.5-1
 - E-Fieldプローブ XF-E 10
 - ケーブル SMA-SMA
 - ケース 240X185X50mm
 - 取扱説明書(英語版)

NEAR FIELD PROBE SET **XF1**

FREQUENCY RANGE 30 MHz TO 6 GHz

特 性	説 明	タイプ
	<p>XF-R 400-1 直径が25mmと大きいので感度が非常に良く、最小の分析が出来る。プローブは装置から10cmまでの距離に使用可能である。HF電磁界の発生源や障害の発生源の位置測定を可能にする。 周波数レンジ 30MHz~6GHz φ約25mm</p>	
	<p>XF-R 3-1 HF電磁界のほとんどの点状の検波を行える。プローブはミリメートル範囲の電磁界の解析まで可能。プローブをより広い範囲を移動させたり、導電経路を別々に移動させたり、またICピン・エリア内やバイパス・コンデンサ、EMCコンポーネント等々でも電磁界の指向性や分布を見つけ出せる。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約1mm</p>	
	<p>XF-B 3-1 平らな装置の表面から垂直に発せられる電磁界の探知用に設計されている。プローブはプリント回路基板の妨げられた部分の測定を可能にするが、XF-R 3-1で出来るような電磁界の指向性測定は実施不可能である。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約2mm</p>	
	<p>XF-U 2.5-1 極小導電経路、コンポーネントの接続部分、コンデンサ、ICピンの流動スペクトル検波用に設計された。プローブヘッドは約0.5mm幅で磁気によって有効な規制を含む。プローブを導電経路やIC、コンデンサ接続部分に置いて計測する。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約0.5mm</p>	
	<p>XF-E 10 電磁界を検知する。プローブのヘッド・チップは幅わずか約0.5mm。約0.2mmの分解が可能なので、個々のトラックが設計図上で評価可能。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約0.2mm</p>	



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和7F
Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp

* 価格・仕様等は変更される場合がございます。最新の情報はお問い合わせください。



Set SX1



- 内容:
- E-Fieldプローブ SX-E03
 - H-Fieldプローブ SX-B3-1
 - H-Fieldプローブ SX-R3-1
 - ケーブル SMA-SMA
 - ケース
 - 取扱説明書(英語版)

NEAR FIELD PROBE SET SX1

FREQUENCY RANGE 1GHz ~ 10GHz

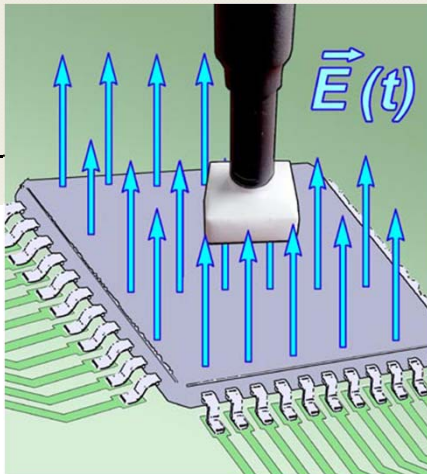
特性	説明	タイプ	プローブヘッド
<p>dBm vs GHz graph for SX-E03. The y-axis ranges from 0 to 80 dBm, and the x-axis ranges from 1 to 10 GHz. The curve shows a slight increase from approximately 40 dBm at 1 GHz to 55 dBm at 10 GHz.</p>	<p>SX-E03 ハット・ニアフィールド・プローブ プローブ・ヘッドは約4×4mmと小さく、プリント回路基板上のシングルコンポーネントのような範囲で電界源を見つけ出します。また測定物(高電界強度)に直接配置することが出来ます。 周波数レンジ 1GHz~10GHz プローブヘッド約4×4mm</p>	<p>Diagram showing the probe tip measuring the electric field (E) in a cross-section of a PCB. Blue arrows indicate the field direction.</p>	
<p>dBµV/m/µA vs GHz graph for SX-B3-1. The y-axis ranges from -80 to 0 dBµV/m/µA, and the x-axis ranges from 1 to 10 GHz. The curve shows a slight increase from approximately -40 dBµV/m/µA at 1 GHz to -20 dBµV/m/µA at 10 GHz.</p>	<p>SX-B3-1 ハット・ニアフィールド・プローブ 測定コイルはプローブのシャフトに角度90度にセット出来ます。プローブヘッドを垂直にセットすることで測定コイルがプリント回路基板表面に直接的に触れるので、プリント回路基板の届きにくいスポットも測定が可能です。デバイスから放たれる電界強度の方向を探し出します。 周波数レンジ 1GHz~10GHz 分解約2mm プローブヘッド約4mm</p>	<p>Diagram showing the probe tip measuring the magnetic field (H) in a cross-section of a PCB. Blue arrows indicate the field direction. Text: "entering field in the top is registered".</p>	
<p>dBµV/m/µA vs GHz graph for SX-R3-1. The y-axis ranges from -80 to 0 dBµV/m/µA, and the x-axis ranges from 1 to 10 GHz. The curve shows a slight increase from approximately -40 dBµV/m/µA at 1 GHz to -20 dBµV/m/µA at 10 GHz.</p>	<p>SX-R3-1 ハット・ニアフィールド・プローブ 小さいプローブヘッドでRF磁場を高分解能に探知します。そのため、より小さいコンポーネントでもインターフェイス源として認識されます。SC-R3-1は、ICピンの周辺のような測定が難しいスポットでも測定可能な様に設計されています。 周波数レンジ 1GHz~10GHz 分解約1mm プローブヘッド約3mm</p>	<p>Diagram showing the probe tip measuring the magnetic field (H) in a cross-section of a PCB. Blue arrows indicate the field direction. Text: "H registered" and "H not registered".</p>	

* 価格・仕様等は変更される場合がございます。最新の情報はお問い合わせください。



ウェーブクレスト株式会社

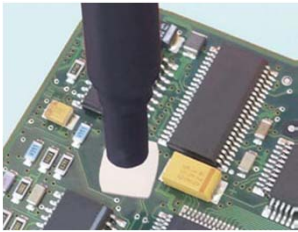
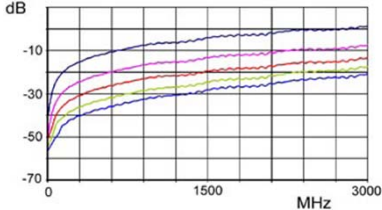

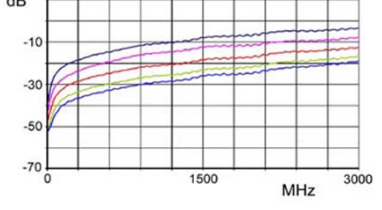

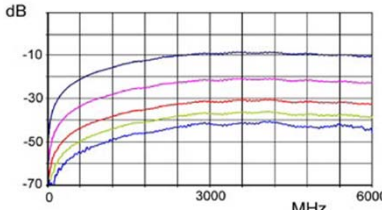
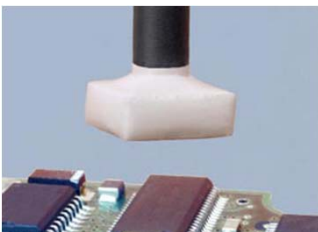
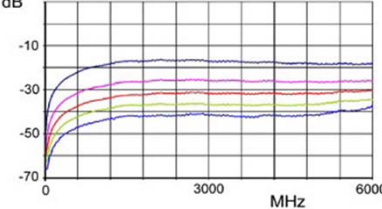
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和7F
 Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp



Langer EMV社の紹介

1992年より事業を開始したLanger社は、顧客から要求のあったEMCの技術的な課題を解決するためのコンサルタント業務を中心に事業を展開しました。その中で、従来の測定設備やツールでは、製品が持つ本質的なEMCの技術的問題点を効率的に解析し解決することが難しいと判断し、この分野に於いてユニークで高性能、効果的な製品を次々と提案してきました。その顕著な製品が、ここに紹介する各種の近磁界・電界プローブであり、従来型の電波暗室ではない低価格で効果的なEMC評価環境を提唱しています。

E FIELD PROBE オプション **RF or XF** FREQUENCY RANGE 30 MHz TO 6 GHz

アプリケーション	詳細	特性
	<p>RF-E 04</p> <p>周波数レンジ: 30MHz~3GHz 電極表面積: 約5×5mm 接続: SMB - RF 注入に使用</p>	
	<p>RF-E 09s</p> <p>周波数レンジ: 30MHz~3GHz 電極表面積: 約10×10mm 接続: SMB - RF 注入に使用</p>	
	<p>XF-E 04s</p> <p>周波数レンジ: 30MHz~6GHz 電極表面積: 約5×5mm 接続: SMA</p>	
	<p>XF-E 09</p> <p>周波数レンジ: 30MHz~6GHz 電極表面積: 約10×10mm 接続: SMA</p>	



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和7F
 Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp

* 価格・仕様等は変更される場合がございます。
 最新の情報はお問い合わせください。



MFA02 set



- 内容**
- マイクロプローブ MFA-R0.2-75
 - マイクロプローブ MFA-K0.1-30
 - バイアスティ(Bias Tee) BT706
 - ケーブル SMA-SMA 1m
 - アクセサリ
 - ケース
 - 取扱説明書(英語版)

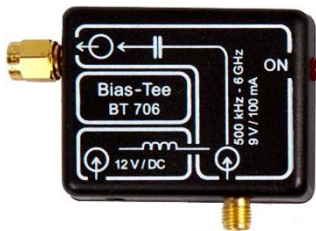


MICRO PROBE SET **MFA02** FREQUENCY RANGE 1MHz ~ 1GHz

特性	説明	タイプ	プローブヘッド
	<p>MFA-R0.2-75 アクティブ磁場マイクロプローブ 極小のプローブヘッドでICピン周辺や極小SMDコンポーネントなどのアッセンブリー上のRF磁場をダイレクトに測定します。 周波数レンジ 1MHz~1GHz 分解能300μm</p>		
	<p>MFA-K0.1-30 アクティブ磁場マイクロプローブ カップリング・クランプのような機能を果たす極小プローブ・ヘッドなので、伝導経路やICピンの電流測定を可能にします。マイクロプローブはプローブヘッド外側に入ってくる力線用にシールドされています。 周波数レンジ 1MHz~1GHz 分解能200μm</p>		

* 価格・仕様等は変更される場合がございます。最新の情報はお問い合わせください。

【バイアスティ BT706】



DC電流を高周波回路へ挿入させる際、高周波信号に影響を与えないように設計されています。バイアスティはスペアナやオシロスコープの50Ω入力に接続できます。

【使用例】



< Hフィールド測定:MFA, XF, LFプローブ >



ニアフィールドプローブとスペアナまたはオシロスコープを使ったEフィールド&HフィールドのRFフィールド測定



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和7F
 Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp